高分解能光電子分光装置の建設と 高温超伝導体フェルミ準位微細電子構造

東北大学理学研究科物理学専攻 放射光・光電子物理研究室 佐藤 宇史

目次

第一章	序論		690
第二章	高分解能光電子分光	装置の建設	691
	2-1	装置の概要	691
	2-2	試料槽······	691
	2-3	試料台、角度分解機構	692
	2-4	温度制御系······	692
	2-5	励起光源系	693
	2-6	分解能向上、性能測定	694
	2-7	達成スペック・・・・・	695
第三章	高温超伝導体 Bi221	2の角度分解光電子分光	696
	3-1	研究背景	696
	3-2	本研究の目的・・・・・	696
	3-3	実験	697
	3-4	結果と考察	697
第四章	高温超伝導体 LSCO	の角度分解能光電子分光	699
	4-1	研究背景	699
	4-2	本研究の目的	699
	4-3	実験	699
	4-4	結果と考察	700
第五章	まとめ・・・・・		701
参考文献			
謝辞			

要旨

高温超伝導体のフェルミ準位近傍の微細電子構造を決定するために、高分解能光電子分光装置の建設 を行った。その結果、従来型の約100倍の強度をもつマイクロ波型高輝度放電管とモノクロメーターの 使用による高輝度単色光での測定の実現、極低温(~4K)での測定、二軸角度分解光電子分光の実現、超 高真空、超高エネルギー分解能(ΔE=4.8meV)を実現した。建設した装置と放射光施設を用いて、高温超 伝導体 Bi2212の角度分解光電子分光を行った。その結果、擬ギャップは超伝導ギャップから連続的に変 化すること、超伝導ギャップサイズのドープ量依存性が擬ギャップの閉じる温度 T*にスケールすること 等を見出した。このことは、角度分解光電子分光で測定された擬ギャップが超伝導の前駆現象であるこ とを示唆している。また、高温超伝導体 La1.85Sro.15CuO4の超高分解能光電子分光の温度変化を測定し た結果、フェルミ準位から 30meV 程度の大きさをもつ擬ギャップを観測した。得られた擬ギャップの温 度変化は、磁化率やホール係数の温度依存性とよく対応する。このことから観測された擬ギャップが反 強磁性相関の発達に対応すると考えられる。この結果は LSCO で観測された擬ギャップが Bi2212 にお いて角度分解光電子分光で決定された擬ギャップとは異なることを示唆している。

^{*}この論文は、私の修士論文「高分解能光電子分光装置の建設と高温超伝導体フェルミ準位微細電子構造」を、物性研究に掲載する原稿として書き直したものである。まとめ直す段階で、東北大学に提出した修士論文と記述に若干の違いが生じたことをあらかじめ断っておく。

第一章 序論

光電子分光のエネルギー分解能は、最近著しい発展を遂げてきた。それにより、今まで 分解能の制約により見えてこなかった様々な微細電子構造が明らかになりつつある。特に 輸送現象や磁性などの物性に深く関与しているフェルミ準位近傍の電子状態は、光電子分 光のみならず物性理解において欠かせない情報である。例えば、髙温超伝導体における超 伝導ギャップ観測や、近藤共鳴ピーク、f 電子の分散、光電子スペクトルの形状などの詳細 な議論は、高分解能を達成して初めて可能になる。高温超伝導体の角度分解光電子分光に 話を限ると、超伝導ギャップや擬ギャップの温度変化の精密測定などはすべてギャップサ イズが大きい Bi2212 に集中してきた現状がある。これまで他の高温超伝導体は、Tc が Bi2212 に比べて比較的低いため従来のエネルギー分解能では不十分だったこと等から角 度分解光電子分光によるギャップの直接観測は困難であった。その様な状況の中で、さら に高いエネルギー分解能を追求すれば、それらの物質の超伝導ギャップの直接観測を含め、 よりエネルギー領域の小さい物理や、精密な議論ができるようになる事は言うまでもない。 具体的には、高温超伝導体では数 meV から 10 数 meV のギャップが期待される物質など で、その超伝導ギャップの開閉、その対称性、擬ギャップの観測をすることは高温超伝導 機構を理解する上でより普遍的な情報を得ることにつながる。また、従来の Bi2212 でも、 スペクトルの形状などの詳細な振る舞いは、分解能の制限で決定的な事は言えなかった。 スペクトルの詳細な温度変化や、ドーピング依存性を測定することによって超伝導ギャッ プと擬ギャップの起源さらには超伝導機構に関しての情報が得られると期待される。これ らを可能にするような装置を建設して、高温超伝導体、さらにそれにに限らず様々な強相 関物質のフェルミ準位近傍の電子状態を明らかにすることは強相関電子系の物理を理解す る上で重要である。本研究では、高温超伝導体の微細電子構造を決定するために高分解能 角度分解光電子分光装置の建設を行い、超高分解能(ΔE=4.8meV)を達成し、放射光を併用 することにより、高温超伝導体 Bi2212 及び LSCO の高分解能角度分解光電子分光を行っ た。

第二章 高分解能光電子分光装置の建設

2-1 装置の概要

図 2-1 に建設した装置の概要を示す。装置は 主に、試料槽、電子エネルギー分析器(アナライ ザー)、光源系、及びそれらを超高真空に保つ 真空排気系からなっている。装置建設は以下の 基本理念に基づいて行った。

- (1)高エネルギー分解能達成のための大型アナ
 - ライザーの使用
- (2)地磁気の影響の軽減のためのミューメタル シールドの使用
- (3)超高真空を得るための大排気容量ターボ分 子ポンプの使用とその直列化
- (4)高輝度単色光での測定
- (5)冷凍機をマニピュレーターに直付けするこ
 - とによる極低温下での測定
- (6)試料の劣化を抑えるための測定時の真空度 の向上

2-2 試料槽

装置の中心部をなす試料槽(図 2-2)には、真 マニビュレータ 空排気系の他に、試料を固定するマニピュレータ ー、角度分解測定で試料を劈開したり、角度積分 測定時に試料表面を研磨したりするためのダイ ヤモンドヤスリ、フェルミ準位の校正に用いる金 の蒸着源、光を入射するための、Exit aperture, Exit stage、二次元角度分解機構が付属している。 メイアモン 試料槽全体は、脱出光電子の軌道を変える地 磁気を軽減するために透磁率の高い二重の



図 2-1 建設した光電子分光装置の概要図



ミューメタルシールドで覆ってある。また試料の劈開や研磨はすべて試料槽内で超 高真空中で行えるようになっている。 低温においては、 真空中に微量に存在する N2 や H2 などが試料に吸着するのを軽減する目的で、気体へリウム循環型クライオポ ンプを設置しており、ガスの吸着及び超高真空化を図っている。

2-3 試料台、角度分解機構

マニピュレーター先端には、試料を取り付ける試料台が取り付けられており着脱可 能になっている。角度分解測定には、アナライザーを動かす場合と、試料を動かす 場合の主に2通りがあるが、この装置はアナライザー固定型のため、必然的に試料 回転型になる。本装置では、マニピュレーターの根本に回転機構がついているため、 一軸角度分解測定が実現される。試料台は、角度積分および1軸方向角度分解用の 最も単純なものと、二軸角度分解専用の外部から回転を行えるもの(図 2-3)の2種

類を製作した。二軸角度分解を行うため に、外部に回転機構を設置し、試料台と かみ合わせ回転させることによって、マ ニピュレータの回転によるブリルアンゾ ーン中の縦方向と、試料台の回転による 横方向のスキャンを併用することによっ て、2次元ブリルアンゾーンの任意の点 での測定が可能になっている。

温度制御系 2-4

試料の温度は、マニピュレーターに取り 付けられた気体ヘリウム循環型クライオ スタットと、電気ヒーターを併用するこ とによって、13.5K~500Kの温度で制御 可能である。マニピュレーターには、熱 気体He循環型クライオスタット 放射によって温度が上昇することを防ぐ 目的で金メッキされた熱遮蔽シールドを かぶせてある。温度は、試料台周辺に取





図 2-4 気体 He クライオスタット使用時の マニピュレーター周辺図

り付けられた白金抵抗体によって測定さ れる (図 2-4)。さらに、これとは別個に、 シリコンダイオード 装置には液体 He 型クライオスタットを液体He注入口(デュアーへ) ヒーター 温度調整コントローラへ 装着できる。温度モニターはシリコンダ 計約 オードセンサーを、試料周辺及びクライ オスタット先端に取り付けることによっ 液体Heクライオスタット 熱遮蔽シールド て行っている。電気ヒーターの出力と温 液体He取り出し口(ロータリーポンプへ) 度をフィードバックすることにより、精 図 2-5 液体 He クライオスタット使用時の 密な温度制御が実現している。到達温度 マニピュレーター周辺図 として、クライオ根本では 2K,試料基板 手前では、4Kの極低温を達成した。(図

2-5 励起光源系

励起光源として、高輝度マイクロ波型放電管(GAMMADATA-SCIENTA)を用いること によって、従来の高電圧印可型の He 放電管に比べて、10 倍から 100 倍の高強度を実現し ている。この放電管は、従来型高電圧印可型に比べて放電時の He の圧力が低いため、励 起光エネルギー幅が狭く、例えば HeIa 線(21.218eV)では従来型の 3.0meV に対し、 1.2meV と、格段に改善されている。さらに、放電管から出た光は複色光であり、光電子 スペクトルに強いサテライト構造を生じさせる。これは、フェルミ準位近傍の微細電子構 造を決定する上で、デメリットとなる。そこで、これらの問題を解決するために、放電管

の下流にトロイダルグレーテ ィングを装備したモノクロメ ー タ ー (GAMMADATA-SCIENTA)を設置し、複色光 の単色化を行った。その結果、 HeIα、HeIβ、HeIIα、HeIIβ 線をそれぞれ選択して、試料 に照射することが可能になっ た。ここで、モノクロメー

2-5)



タの性能を評価するために、 金の光電子スペクトルを、 分光した Hela(21.218eV) 線、及び0次光で比較を行 った。フェルミ準位近傍(図 2-6)では、この二つに顕 著な違いが見受けられ、0 次光による測定では、フェ ルミ準位より上のバックグ ラウンドが高く、かつ状態 密度の傾きも正確に再現し



ていないことがわかる。状態密度の傾きの違いは、0 次光を励起光源とした場合に、 HeIαによるフェルミ準位近傍の光電子スペクトルに、約 2eV 波長が異なる HeIβ による荷電子帯の裾がのっていることや、2 次電子の強度の違いのため生じると思 われる。フェルミ準位より上のバックグラウンドの上昇は、HeII等のサテライトに よる影響である。また、価電子帯のスペクトルに着目すると(図 2-7)、0 次光の場 合は、単色化光に比べてスペクトルがプロードになっているように見え、2 次電子 によるバックグラウンドの強度が増していることがわかる。以上の事から、単色光 を用いた測定は、光電子スペクトルの詳細を議論する上で欠くことの出来ない要素 の一つであると言える。

2-6 分解能向上、性能測定

光電子分光のエネルギー分解能は、(1)電子エネルギー分析器の分解能、(2)放電管 からの光のエネルギー幅、(3)それ以外の影響、の主に3つの要素によって決定され る。高エネルギー分解能化のために、(1)に関しては、大きな静電半球型アナライザ ーを使用し、アナライザーの測定電圧設定をソフトウェア的に微調整し、検出器部 分のハードウェア的な設定を行うことによって分解能を向上した。(2)に関しては、 前述の様に、高輝度でエネルギー幅の非常に狭い放電管を使用した。(3)に関しては、 電源系の配線に工夫を凝らし、地磁気を軽減するミューメタルシールドを取り付け、 アナライザーの消磁を行う事等により分解能を向上させた。図 2-8 にアナライザー の分解能を見積もるために測定した気体 Ar3p 軌道の光電子スペクトルを示す。得 られたスペクトルの FWHM が 5.4meV であることから、Ar の持つドップラー幅 を考慮して計算した結果、アナライザー が 2.8meV という超高分解能を達成し た事がわかった。また、固体における分 解能を見積もるために、標準試料として 蒸着された金のフェルミ準位近傍の光電 子スペクトルの測定を行った(図 2-9)。 13.5K におけるフェルミ分布関数を考 慮に入れたフィッティング計算の結果、 装置全体では、世界最高水準である 4.8meV という超高分解能を達成してい る事がわかった。ここで、測定前後で、 フェルミ準位の見積もりは、誤差の範囲 (0.1meV)でずれない事を明記しておく。



図 2-9 分解能最適化後の金のフェルミ準位近傍の 光電子スペクトル

2-7 達成スペック

建設により得られた本装置のスペックを、以下に表としてまとめる。

アナライザーエネルギー分解能(気体)	2.8meV
装置エネルギー分解能(固体)	4.8meV
角度分解能	±1°
測定温度範囲	
気体 He 循環クライオスタット使用時	13.5K~500K
液体 He 循環クライオスタット使用時	4K~
到達真空度(試料槽)	4.5×10 ⁻¹¹ Torr
測定時の真空度	1.2×10 ^{.9} Torr

を示唆している。

第三章 高温超伝導体 Bi2212 の角度分解光電子分光

3-1 研究背景

高温超伝導体 Bi2212 は、Tcが~90K と高く、劈開が非常に容 M Г $(\pi, 0)$ (0,0) 易であり、真空中で試料表面が安定なため、以前から精力的に角 度分解光電子分光が行われてきた。その結果、ブリルアンゾーン (図 3-1)中の(π, π) (X(Y))点を中心とした大きなホール的なフェ M Y(X)ルミ面を見出し[1]、超伝導ギャップの波数依存性を直接観測する^(Q,π) (π.π) 図 3-1 Bi2212 のブリルアンゾーン ことにより超伝導ギャップが異方的な dx2-y2 波 Superconducting state 対称性をもつ事が明らかになり[2.3]、さらに、 Gap size アンダードープ領域で Tc よりも上の温度で、 $dx^{2}-v^{2}$ Δ0 常伝導擬ギャップが存在し、ある温度 T*で閉じ M る[4-7]事が報告されてきた。更に、ブリルアン ゾーン中の複数の点での温度変化を測定する事 により、T*よりも上で存在していた閉じたフェ Y(X) M ルミ面が、T*以下になると(π,0)点(M 点)を中 Continuous Pseudogap state 心としてギャップが開き始め、とぎれた形状を Gap size もつギャップレスフェルミアークが、そのまま 超伝導状態の dx2-v2 波的なギャップに移行する M ことが明確に観測されている(図 3-2)[7]。この 実験事実は角度分解光電子分光で観測された擬 ギャップが、超伝導と密接に関係していること Y(X)

図 3-2 ギャップの大きさの波数、温度依存性

3-2 本研究の目的

角度分解光電子分光によって見出されたアンダードープ領域における擬ギャップは、他の実験で観測される異常や超伝導機構との兼ね合いから精力的な議論がなされてきた。しかしながら、擬ギャップの起源に関しては未だ統一見解が得られていない。この問題に関して、光電子分光のエネルギー分解能を更に高め、Tc 前後のより詳細な電子状態の温度変化をとらえることが出来れば、擬ギャップの起源に関してのアプローチが可能になると考

えられる。更に、擬ギャップは前述のように温度減少とともにブリルアンゾーン中の(π,0) 点 (M 点)から開き始めることが報告されており[7]、この事は、 (π,0)点における光電子 スペクトルの形状と擬ギャップが密接に関係しているということを表している。つまり、 (π,0)点付近の光電子スペクトルの系統的測定(運動量、温度、ドープ量依存性)を行い、 解析することによっても、擬ギャップの起源が明らかになると考えられる。本研究では、 最近建設した超高分解能光電子分光装置と放射光施設を併用することによる、Bi2212 の 角度分解光電子分光の結果について報告し、擬ギャップの起源について考察する。

3-3 実験

Bi2212 単結晶試料は、筑波大物工の門脇和男教授、金材技研の茂筑高士博士から提供し て頂いた。光電子分光実験は、建設した超高分解能光電子分光装置と米国ウィスコンシン 放射光施設 4m-NIM (Normal Incidence Monochromator) beam line を用いて行った。前者につい ては、分解能 7meV、励起光源 HeIα線(21.218eV)を用い、後者については、分解能17meV ~30meV、励起光エネルギー22eV を用いた。光電子分光に必要な清浄表面は 10×10-"Torr 台の超高真空下で試料を劈開することによって得た。

図 3-3 に、超高分解能光電子分光装置を用 いて測定された最適ドープ Bi2212 の(π,0) 点での超高分解能光電子スペクトル (ΔE=7meV)の温度変化を示す。得られた光電 子スペクトルは、低温でフェルミ準位近傍に 鋭いコヒーレントピークを形成し、温度上昇 とともにその強度を落とす一方で、フェルミ 準位上の強度は温度上昇とともに系統的に 上昇している。それと同時にスペクトルの立 ち上がりの中点がフェルミ準位に近づいて いくことが明確に観測されており、これはギ ャップが徐々に閉じていくことに対応する。 また、Tc 前後のスペクトルの変化に着目す







ると、コヒーレントピークはちょうどTcで 消えている。超伝導相から擬ギャップ相に移 り変わるに連れて、スペクトルに何ら不連続 な変化が見受けられないことから、擬ギャッ プは超伝導と密接に関係している先駆現象 である可能性が示唆される。また、フェルミ 分布関数の効果を消して生のスペクトル関 数の温度変化を得るために、スペクトルの対 称化解析[7]を行った(図 3-4)。90K~120K までのスペクトルに、130Kのスペクトルを 重ねて示した。110,120Kのスペクトルは 130Kのものと良く重なる一方で、90-100K



図 3-4 得られたスペクトルを対称化[7]したもの

のスペクトルは、130K とずれが生じる。このことは、最適ドープでも擬ギャップが開い ており、T*が~110K である事を示している。また、コヒーレントピークの幅の解析の結 果、分解能 7meV での測定におけるピーク幅は約 25meV であり、コヒーレントピークは Resolution limited ではないことが明らかになった(図 3-5)。さらに、放射光を使った(π,0)

点における光電子スペクトルの ドーピング依存性の測定の結果、 超伝導ギャップのサイズはキャ リアー濃度増加とともに小さく なり、超伝導ギャップのサイズ と、角度分解光電子分光で決定 した T*の間に、大まかな比例関 係があることがわかった。この ことからも、擬ギャップは、超 伝導と密接に関係し、何らかの ペアリングによる可能性が高い ことが示唆される。



第四章 高温超伝導体 LSCO の角度分解光電子分光

4-1 研究背景

高温超伝導体 La2-xSrxCu2O4 (LSCO)は、1 枚の CuO2 面を持つことから、二枚を有する Bi2212 に比べてより単純な CuO2 面に関する情報が得られることが期待される。さらに、 La を Sr で置換してドープ量を制御する事から、Bi2212 に比べて幅広いドープ量での系 統的な測定が可能である。常伝導状態におけるアンダードープ領域でも、様々な物性にお ける異常が報告されている。だが残念なことに、*Tc*が比較的低い(~40K)ため超伝導ギャ ップサイズが小さいと期待されること、角度分解測定に必要な劈開が非常に困難なこと等 から、光電子分光におけるギャップの測定は行われていなかった。その中でも、最近 A. Ino らは、精力的な光電子分光のドーピング依存性の測定により、最適ドープ、アンダードー プ領域で 0.1~0.2eV の大きさをもつ、"high-energy pseudogap"を報告している[8]。し かしながら、"high-energy pseudogap"が、Bi2212 で観測される様な"small pseudogap" にどう相関しているのか、さらに超伝導ギャップとどう関係しているのかは、温度変化の 報告がされていないことや、これまで分解能が超伝導ギャップを直接観測するには必ずし も十分では無かったことなどから、はっきりはしていない。

4-2 本研究の目的

前述の"high-energy pseudogap"と"small pseudogap"が全ての高温超伝導体に普遍の特 徴であるのかどうか、それらがどのように相関しているのかどうかを知るためには、超伝 導ギャップと同じか、それ以上のエネルギー分解能での光電子分光の温度変化を測定する 必要がある。本研究では、建設した超高分解能光電子分光装置を用いて最適ドープ La1.85Sr0.15CuO4の超高分解能光電子分光を行った。

4-3 実験

最適ドープ La1.85Sr0.15CuO4単結晶試料(Tc=38K)は、京都大学化学研究所の山田和芳教 授から提供して頂いた。光電子分光は、建設した超高分解能光電子分光装置を用いて行い、 励起光源として HeIα線(21.218eV)を用いた。測定に必要な清浄試料表面は、超高真空下 で試料を 30 分毎に研磨することによって得た。

4-4 結果と考察

図 4-1(a)に、最適ドープ La1.85Sr0.15CuO4 (*Tc* =38K)の超高分解能光電子スペクトルの温 度変化を示す (挿入図は金の温度変化)。典型的な金属である金はフェルミ準位(*Er*)をはさ んで対称的な温度変化を示し、スペクトルの交点が温度変化に際して全て *Er*上で交わって いるているのに対し、LSCO はスペクトルの交点が全ての温度領域にわたって高結合エネ ルギー側に位置し、*Er*の強度が 250K という高温においても系統的に上昇していることが わかる。これは、常伝導状態において *Er*近傍で状態密度の変化があることをを意味してい る。そこで、状態密度の温度変化を明確にするために、スペクトルを装置分解能でコンボ リューションした各温度におけるフェルミ分布関数で割った[9]ものを図 4-1(b)に示す。こ の図は基本的には状態密度に対応するものであると見なせる。この図から、温度上昇とと

もに、フェルミ準位近傍約30meVの範囲の強度 が系統的に上昇しているのに対し、それより高 結合エネルギー側の 100-150meV の範囲ではス ペクトル強度が減少していることがわかる。こ れは、温度上昇に伴い、100-150meVから 30meV-EFにスペクトルウェイトの移動があり、 低温で開いた擬ギャップが徐々に閉じていくこ とを意味している。フェルミ準位近傍をより詳 しく見ると(図 4-1(c))、スペクトルの温度変化 は、常に 30-35meV で起こっており、温度によ らない。この値は、A. Ino らによる"high-energy pseudogap"[5]のエネルギーの約 1/3 に対応する。 また、超伝導状態の光電子スペクトルからフィ ッティングにより超伝導ギャップの大きさを見 積もった。始めに、超伝導ギャップの対称性と して、s 波とd 波の両方を仮定した BCS 関数に よるフィッティングを行った。得られた計算結 果は実験データを良くは再現していない。そこ で、何らかのブロードニング機構が働いている



(b)得られた状態密度、(c)その拡大図

と考えて、BCS 関数にブロードニングをかけた Dynes の式を用いてフィッティングを行った (図 4-2)。得られた結果から、超伝導ギャップ の大きさ(最大値)は 8±1meV であり、ここか ら $2\Delta/kBTc\sim5.2$ と見積もられる。この結果は、 中性子散乱で得られた $2\Delta/kBTc\sim6[10]$ や、 Bi2212 における $2\Delta/kBTc\sim5.5[11]$ に良く対応 する。超伝導ギャップの大きさが観測した擬ギ ギャップのエネルギースケールに比べてが数倍 小さいことから、LSCO で観測された擬ギャッ プは超伝導ギャップとは起源が異なる事が示唆



される。本実験における特徴的なエネルギースケールである 30-35 meV (温度に換算して~400K)は、磁化率が最大値を持つ温度 Tmax(~400K at x=0.15)[12]や、ホール係数が温度 減少とともに増加し始める温度(~500K)と良く対応している。このことから、この測定で 観測された光電子スペクトルの温度変化は、反強磁性相関の発達に対応するものである事 が考えられる。以上の事から、本実験で観測された LSCO の擬ギャップは Bi2212 の角度 分解光電子分光で観測された、ペアリングが関係していると思われる擬ギャップとは異な っている事が示唆される。今後二つの擬ギャップの相互関係や起源、さらに超伝導機構と の関係を明らかにする必要がある。

第五章 まとめ

高温超伝導体のフェルミ準位近傍の微細電子構造を明らかにするために超高分解能光電 子分光装置の建設を行った。建設した装置は以下の特徴を持つ。

(1)超高エネルギー分解能(ΔE=4.8meV)の達成

(2)極低温下(4K~)での測定

(3)高輝度単色光での測定

(4)2軸角度分解光電子分光の実現

(5)超高真空下(4.5×10-11Torr)での測定

・建設した装置と放射光施設を用いて高温超伝導体 Bi2212 の角度分解光電子分光を行った。その結果以下の事を見出した。

(1)最適ドープでも擬ギャップが存在し、T*=110K である

(2)擬ギャップは超伝導ギャップから連続的につながる

(3)コヒーレントピークは Resolution limited では無い

(4)超伝導ギャップの大きさのドープ量依存性は T*にほぼスケールする 以上の結果から、角度分解光電子分光で見出された擬ギャプは、超伝導と密接に関係した 先駆現象で、ペアリングに関係している事を示唆している。

・建設した装置を用いて高温超伝導体 La1.85Sr0.15CuO4の角度分解光電子分光を行った。 その結果以下の事を見出した。

(1)常伝導状態において、EF近傍で 30-35meV 程度の擬ギャップが存在する。

(2)擬ギャップは温度上昇とともに閉じていき、そのウェイトを高結合エネルギー 側に移動する

(3)少なくとも室温程度まで、EF近傍の状態密度は変化する

(4)得られたスペクトルの温度変化は、磁化率やホール係数と良く対応する。

(4)フィッティングにより得られた超伝導ギャップの大きさは 8meV

以上の結果から、LSCO で観測された擬ギャップは Bi2212 の角度分解光電子分光で観測 された、ペアリングが関係していると思われる擬ギャップとは異なり、反強磁性相関の発 達によるものである事が示唆される。今後二つの擬ギャップの相互関係や起源、さらに超 伝導機構との関係を明らかにする必要がある。

参考文献

[1] H. Ding et al., Phys. Rev. Lett. 78, 2628 (1997).

[2] Z.-X. Shen et al., Phys. Rev. Lett. 70, 1553 (1993).

[3] H. Ding et al., Phys. Rev. B 54, R9678 (1996).

[4] D. S. Marchall et al., Phys. Rev. Lett. 76, 4841 (1996).

[5] H. Ding et al., Nature 382, 51 (1996).

[6] A. G. Loeser et. al., Science 273, 325 (1996).

- [7] M. R. Norman et al., Nature 392, 157 (1998).
- [8] A. Ino et al., Phys. Rev. Lett. 81, 2124 (1998).
- [9] H. Kumigashira et al., Phys. Rev. Lett. 82, 1943 (1999).
- [10] K. Yamada et al., Phys. Rev. Lett. 75, 1626 (1995); K. Yamada et al., Phys. Rev. B 57, 6165 (1998).
- [11] T. Yokoya et al., Solid State Comm. 87, 553 (1993).
- [12] T. Nakano et al., Phys. Rev. B 49, 16000 (1994).
- [13] T. Nishikawa et al., J. Phys. Soc. Jpn. 63, 1441 (1994); H. Y. Hwang et al., Phys.
 Rev. Lett. 72, 2636 (1994).

謝辞

高橋隆助教授には、本研究のテーマを与えていただくとともに、熱心で懇切丁寧なご指 導のもとで修士論文を書き上げることができたことを深く感謝いたします。

横谷尚陸博士、組頭広志氏には、研究を行うに当たっての心構え、データ解析や実験の手法、論文の書き方、有益な議論など、多大なご指導をいただいた事を深く感謝します。

共同研究をしていただいた、名古屋大学の竹内恒博博士、ボストン大学の H. Ding 博士、 米国アルゴンヌ研究所、イリノイ大学の A. Kaminski 氏、 H. Fretwell 博士、 J. Mesot 博士、 M. R. Norman 博士、J. C. Campuzano 教授には深く感謝いたします。

Bi2212の単結晶試料を提供していただいた科学技術庁金属材料研究所の門脇和夫教授、 筑波大学物質工学系の茂筑高士博士、LSCOの試料を提供していただいた京都大学化学研 究所の山田和芳教授に深く感謝いたします。

実験方法、データの解釈等で多大なご指導をいただき、さらに、光電子分光法や固体物 理の基礎のみならず、研究の心構えから熱心にご教示いただいた、本研究室の佐藤繁教授、 鈴木章二助教授、田中章順助手、金亨度博士、A. Chainani 博士に深く感謝いたします。

藤澤英樹氏、伊藤孝寛君、内藤寧典君、中井俊之君、ディヌ・イオネル君、神山知之君、 相馬清吾君及び佐藤健技官をはじめとする本研究室の諸兄姉に深く感謝いたします。

最後に、このような機会を与えていただき、精神的にも経済的にも支えていただいた両 親に深く感謝いたします。